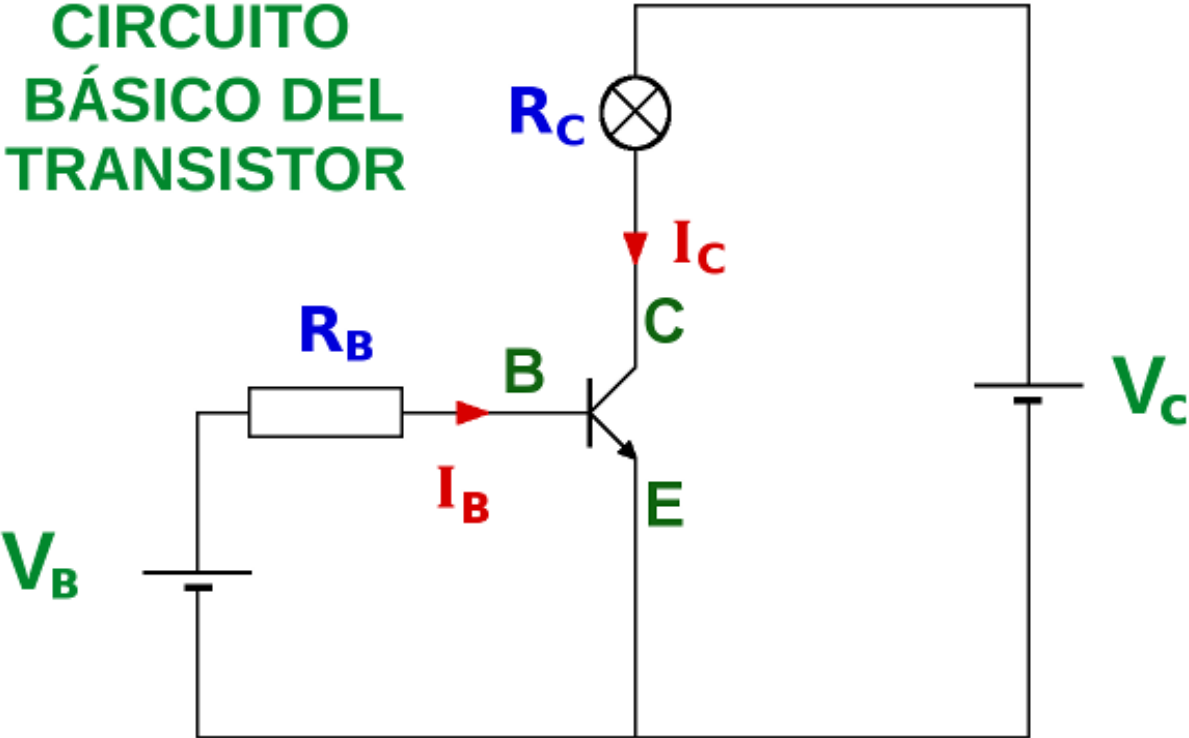


CIRCUITO
BÁSICO DEL
TRANSISTOR



ZONAS DE TRABAJO DEL TRANSISTOR BIPOLAR

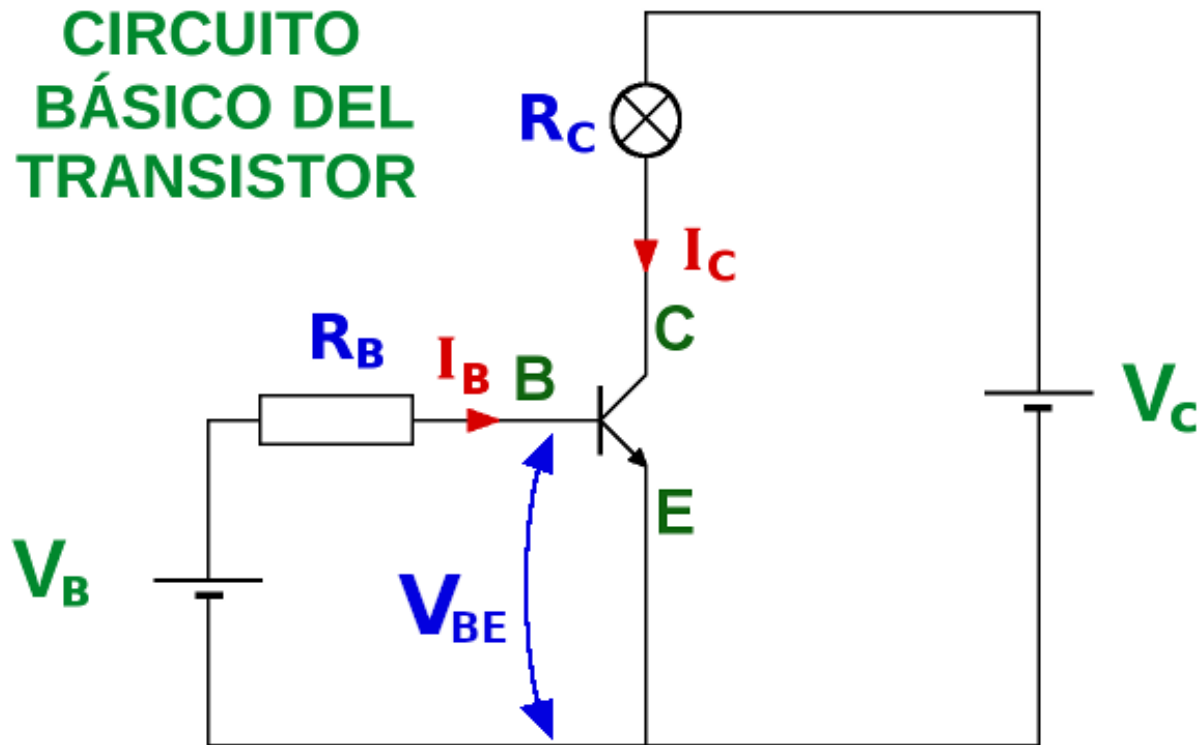
ZONA DE TRABAJO	MAGNITUDES	EQUIVALENTE
CORTE	$V_B < 0,7V$ $I_B = 0 \text{ A}$ ó muy pequeña $I_C = 0 \text{ A}$	
ACTIVA	$V_B \geq 0,7V$ $I_B = \text{valor medio}$ $I_C = \beta * I_B$ β entre 30 y 200 según modelo de transistor EFECTO AMPLIFICADOR I_C PROPORCIONAL A I_B (R VARIABLE O TRANS-RESISTOR)	
SATURACIÓN	$V_B \gg 0,7V$ $I_B = \text{valor elevado}$ $I_C = \text{MÁXIMO POSIBLE} \neq \beta * I_B$ ($I_C < \beta * I_B$)	

ZONAS DE TRABAJO DEL TRANSISTOR BIPOLAR

ZONA DE TRABAJO	MAGNITUDES	EQUIVALENTE UNIFICADO
CORTE	$V_B < 0,7V$ $I_B = 0 \text{ A}$ ó muy pequeña $I_C = 0 \text{ A}$	
ACTIVA	$V_B \geq 0,7V$ $I_B = \text{valor medio}$ $I_C = \beta * I_B$ β entre 30 y 200 según modelo de transistor EFFECTO AMPLIFICADOR I_C PROPORCIONAL A I_B (R VARIABLE O TRANS-RESISTOR)	
SATURACIÓN	$V_B \gg 0,7V$ $I_B = \text{valor elevado}$ $I_C = \text{MÁXIMO POSIBLE} \neq \beta * I_B$ ($I_C < \beta * I_B$)	

NOTA: No confundir V_B con V_{BE} :

CIRCUITO BÁSICO DEL TRANSISTOR

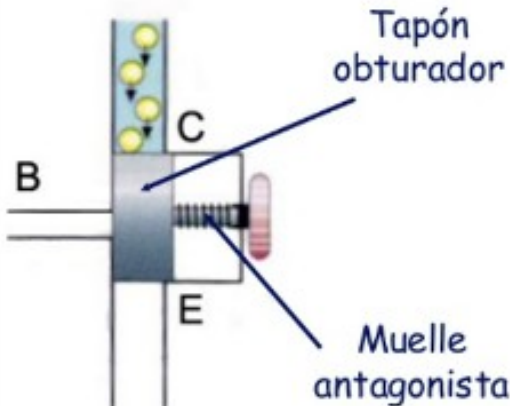
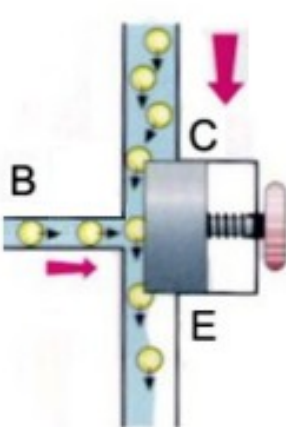


Siempre $V_B \geq V_{BE}$

EN ZONA DE CORTE $V_{BE} < 0,7V$

EN ZONA ACTIVA O SATURACIÓN $V_B \geq V_{BE} \approx 0,7V$

ZONAS DE TRABAJO DEL TRANSISTOR BIPOLAR

ZONA DE TRABAJO	MAGNITUDES	SÍMIL HIDRÁULICO
CORTE	$V_B < 0,7V$ $I_B = 0 A$ ó muy pequeña $I_C = 0 A$	<p>Transistor en corte</p> 
ACTIVA	$V_B \geq 0,7V$ $I_B =$ valor medio $I_C = \beta \cdot I_B$ β entre 30 y 200 según modelo de transistor EFFECTO AMPLIFICADOR I_C PROPORCIONAL A I_B (R VARIABLE O TRANS-RESISTOR)	<p>Transistor en activa</p> 
SATURACIÓN	$V_B \gg 0,7V$ $I_B =$ valor elevado $I_C =$ MÁXIMO POSIBLE $\neq \beta \cdot I_B$ ($I_C < \beta \cdot I_B$)	<p>Transistor en saturación</p> 